

Исправления

к статье А. Н. Ганьшин, В. Н. Григорьев, В. А. Майданов, Н. Ф. Омелаенко, А. А. Пензев, Э. Я. Рудавский, А. С. Рыбалко, Ю. А. Токарь «Кинетика роста и растворения включений ^3He в расслоившихся твердых растворах ^3He в ^4He » (*ФНТ* 25 № 8/9 с. 796–814 (1999)). *Рис. 21* должен иметь вид:

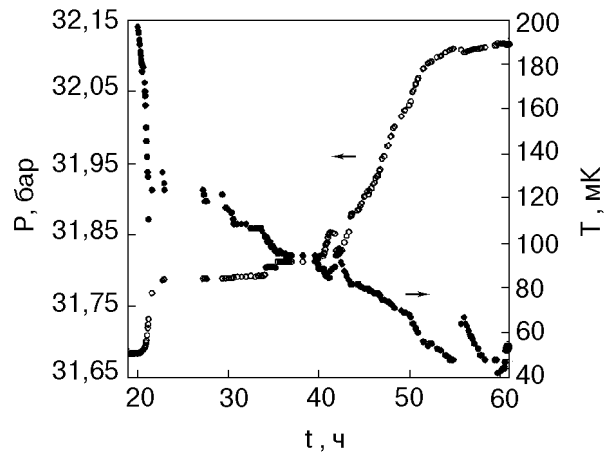


Рис. 21. Термограмма охлаждения кристалла и соответствующее изменение давления, иллюстрирующее расслоение при 100 мК и плавление образовавшихся включений ^3He при дальнейшем охлаждении, $V = 20,54 \text{ см}^3/\text{моль}$.